

2SC3907

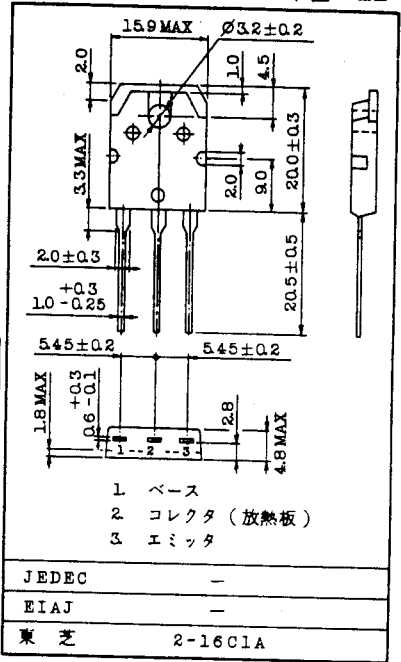
シリコンNPN三重拡散形トランジスタ

○ 電力増幅用

特長

- ・ 高耐圧です。: $V_{CEO}=180V$ (最小)
- ・ 2SA1516 とコンプリメンタリになります。
- ・ 80W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。

単位: mm



最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	12	A
ベース電流	I_B	12	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ C$)	P_C	130	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゅ断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=180V, I_E=0$	-	-	50	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	-	-	50	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50mA, I_B=0$	180	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	55	-	180	-
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=7A$	35	70	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=8A, I_B=0.8A$	-	0.3	2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=7A$	-	1.0	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	-	30	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	-	270	-	pF

注: $h_{FE(1)}$ 分類 R: 55~110, O: 90~180